



Микросхема К284СС2А (К2СС842А)
К284СС2Б (К2СС842Б)

ПАСПОРТ

**ГИБРИДНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ
ТИПА К284СС2А, К284СС2Б**

1. Функциональное назначение

Схемы селекции и сравнения, содержащие в себе два самостоятельных истоковых повторителя и инвертирующий усилитель, предназначенные в основном для активных РС-фильтров.

- 2. Габариты: 14,5×19,5×5 мм
- 3. Режимы работы:

- а) напряжение питания 6 В±10%, минус 6 В±10%
- б) мощность, потребляемая от источников питания, не более 100 мВт

4. Основные электрические параметры

Наименование параметра	Н о р м а	
	истоковые повторители	инвертирующ. усилит.
1*. Коэффициент усиления напряжения повторителей на частоте 40 Гц при температуре 25°С		
К284СС2А	не менее	0,988
К284СС2Б		0,98
К284СС2А	не более	1,0
К284СС2Б		1,0
Изменение коэффициента усиления напряжения при изменении температуры от минус 45 до 25°С, %, не более		±1,0
от 25 до 55°С, %, не более		±0,8
2*. Коэффициент усиления напряжения инвертирующего усилителя на частоте 40 Гц в диапазоне температур окружающей среды от минус 45 до 55°С, не менее		200
3*. Входное сопротивление истоковых повторителей при нормальных климатических условиях на частоте 40 Гц, МОм, не менее		400
4*. Входное сопротивление инвертирующего усилителя при нормальных климатических условиях на частоте 40 Гц, МОм, не менее		10
5*. Входная емкость при нормальных климатических условиях, пФ, не более		10
6. Выходное сопротивление при нормальных климатических условиях, Ом, не более	75	350

Наименование параметра

Н о р м а

истоковые повторители

инвертирующ. усилит.

7*. Выходное напряжение покоя при нормальных климатических условиях и подаче на вход нулевого потенциала для истоковых повторителей, В, не более —1
для инвертирующего усилителя в режиме масштабного усиления с коэффициентом $K=1$, В, не более ± 1

* Измерение параметров производится при $R_{in} = 10 \text{ кОм} \pm 5\%$ и $C_{in} = 40 \text{ пФ}$

5. Содержание золота на 1000 шт. — 42,901 г.

Схема электрическая принципиальная

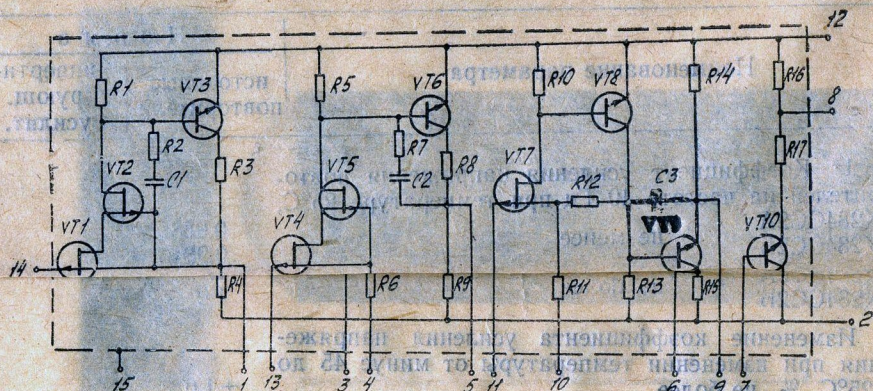
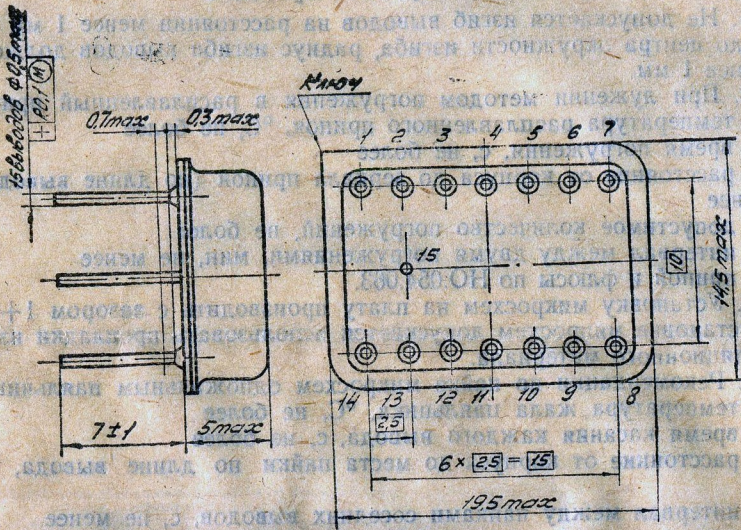


Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь	
1	Выход истокового повторителя 1	* Назначение выводов определяется функциональным использованием микросхемы.
2	6В	
3	*	
4	*	
5	Выход истокового повторителя 2	
6	Выход инвертирующего усилителя	
7	Вход эмиттерного повторителя	
8	Выход эмиттерного повторителя	
9	*	
10	*	* Входная емкость при нормальных климатических условиях не более 40 пФ
11	Вход инвертирующего усилителя	
12	минус 6В	
13	Вход истокового повторителя 2	
14	Вход истокового повторителя 1	
15	Общий	

Габаритный чертеж микросхемы



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1	Резистор 6,0 кОм ± 20%	1	
R2	Резистор 2,0 кОм ± 20%	1	
R3	Резистор 120 Ом ± 30%	1	
R4	Резистор 6,5 кОм ± 20%	1	
R5	Резистор 6,0 кОм ± 20%	1	
R6	Резистор 2,2 кОм ± 15%	1	
R7	Резистор 2,0 кОм ± 20%	1	
R8	Резистор 120 Ом ± 30%	1	
R9	Резистор 6,5 кОм ± 20%	1	
R10	Резистор 1,5 кОм ± 15%	1	
R11	Резистор 1,2 кОм ± 15%	1	
R12	Резистор 1,0 кОм ± 20%	1	
R13	Резистор 10 кОм ± 20%	1	
R14	Резистор 2,7 кОм ± 20%	1	
R15	Резистор 10 кОм ± 20%	1	
R16	Резистор 6,0 кОм ± 30%	1	
R17	Резистор 120 Ом ± 20%	1	
C1, C2	Конденсатор 15 пФ ± 20%	2	
C3	Конденсатор 33 пФ ± 20%	1	
VT1, VT4	Транзистор 2П201А-1 ТФЗ.365.006 ТУ	2	или КР201Е-
VT2, VT5 VT3, VT6, VT8, VT9,	Транзистор 2П201В-1 ТФЗ.365.006 ТУ	2	или КР201И-
VT10	Транзистор 2Т332В ХМО.336.004 ТУ	4	
VT7	Транзистор 2П201Б-1 ТФЗ.365.006 ТУ	1	1

Отношение сопротивлений резисторов $\frac{R10}{R11} = 1,19 - 1,32$

Примечание. Допускается использование транзистора 2П201В-1 ТФЗ.365.006 ТУ или КР201Ж- и КР201И- ТФЗ.365.006 ТУ!

6. Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации

- 6.1. Не допускается изгиб выводов на расстоянии менее 1 мм от корпуса до центра окружности изгиба, радиус изгиба выводов должен быть не менее 1 мм.
- 6.2. При лужении методом погружения в расплавленный припой:
- температура расплавленного припоя, °С, не более 250
 - время погружения, с, не более 2
 - расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм, не менее 1
 - допустимое количество погружений, не более 2
 - интервал между двумя погружениями, мин, не менее 5
 - припой и флюсы по НО.054.063.
- 6.3. Установку микросхем на плату производить с зазором $1+0,5$ мм. При установке микросхем допускается использовать прокладки из электроизоляционного материала.
- 6.4. Рекомендации по пайке микросхем одножальным паяльником:
- температура жала паяльника, °С, не более 280
 - время касания каждого вывода, с, не более 3
 - расстояние от корпуса до места пайки по длине вывода, мм, не менее 1
 - интервал между пайками соседних выводов, с, не менее 10
 - жало паяльника должно быть заземлено.
- 6.5. Рекомендации по групповой пайке:
- температура расплавленного припоя, °С, не более 265
 - время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы), с, не более 3
 - на расстоянии не менее 1 мм от корпуса (по длине вывода);
 - интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мин, не менее 5
- 6.6. Рекомендации по очистке от флюса, влагозащите и приклейке:
- рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с нормалью НО.054.063;
 - рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231 МРТУ6-10-863-69 или Э4100, МРТУ6-10-857-69;
 - после распайки микросхемы с платами должны быть защищены лаком не менее, чем в 2 слоя;
 - приклейку рекомендуется производить клеями АК-20 или мастикой «ЛН».
- 6.7. Допускается однократный монтаж микросхем на платы с гарантированным сохранением электрических параметров при формовке выводов и двухкратный — без формовки выводов.

7. Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от минус 45° до 55°С.
- Относительная влажность воздуха до 98% при $T=25^{\circ}\text{C}$.
- Вибрация с ускорением до 10g в диапазоне частот от 2 до 600 Гц.
- Многочрезные удары с ускорением 75g.
- Линейные (центробежные) ускорения до 25g.
8. Время гарантийной наработки — 10000 ч.
9. Срок хранения — 6 лет.
10. Гарантии предприятия-изготовителя.
- Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем потребителю.
11. Масса — 4,5 г.
12. Дата выпуска.

Микросхемы типа К284СС2А, К284СС2Б соответствуют техническим условиям 6КО.348.022 ТУ

